# 集積化CMOS-MEMS加速度センサに向けたSub-1Gセンサ

## A Sub-1G Sensor for Integrated CMOS-MEMS Accelerometer

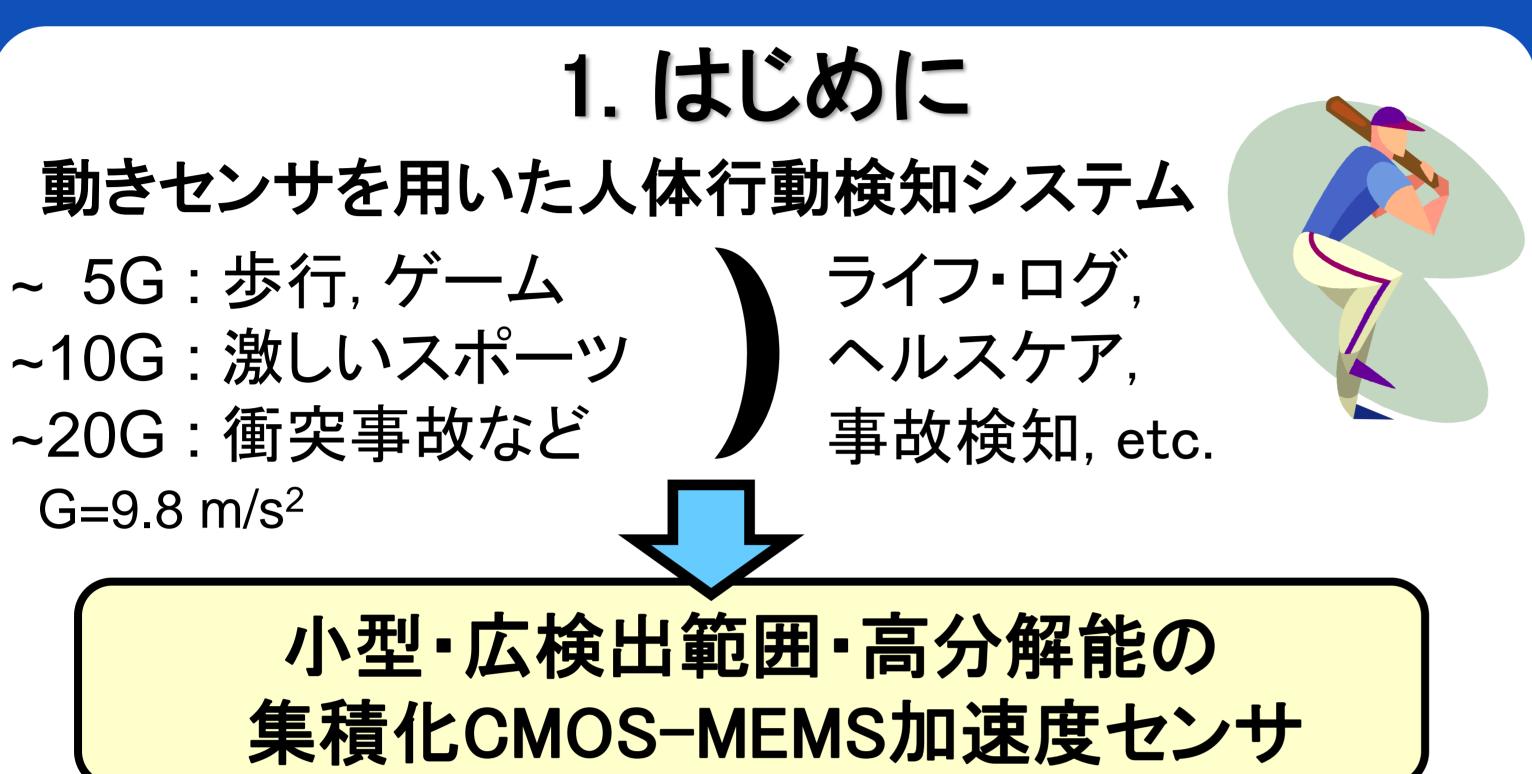
山根 大輔1%, 亀井 将太1, 小西 敏文2, 松島 隆明2, 年吉 洋3, 益 一哉1, 町田 克之1,2

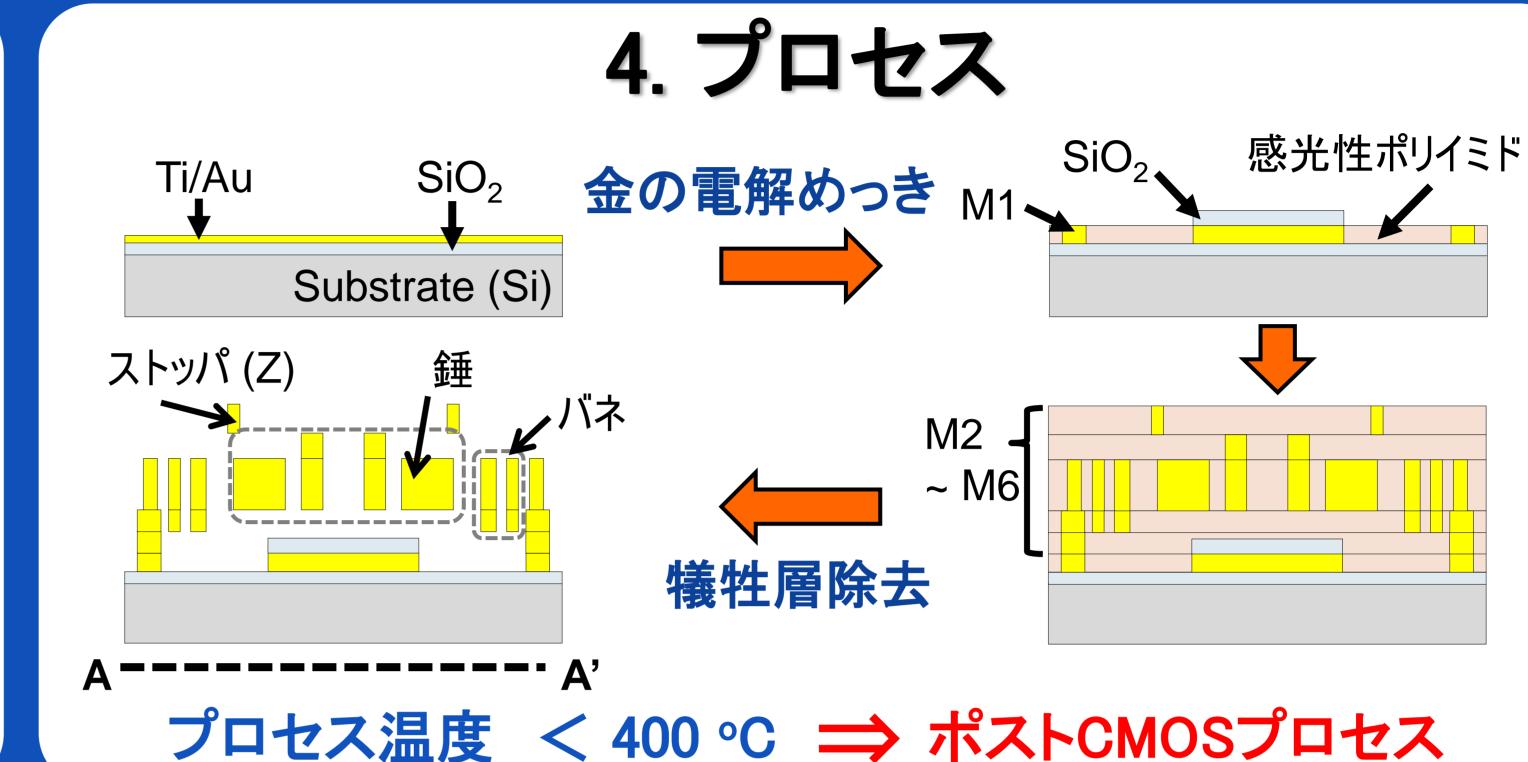
1東京工業大学, 2NTTアドバンステクノロジ株式会社, 3東京大学

Masu Group

Tokyo Tech

\*\*Tel: +81-45-924-5031, E-mail: yamane.d.aa@m.titech.ac.jp



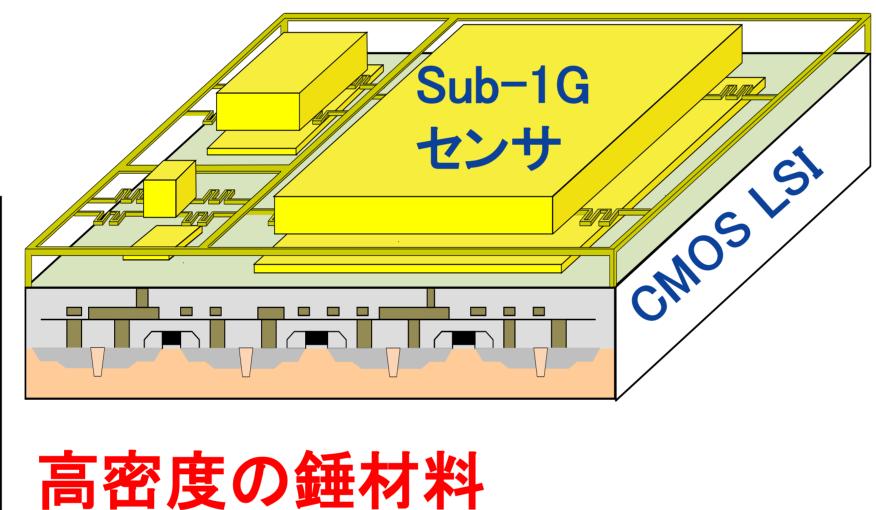


#### 2. 研究手法



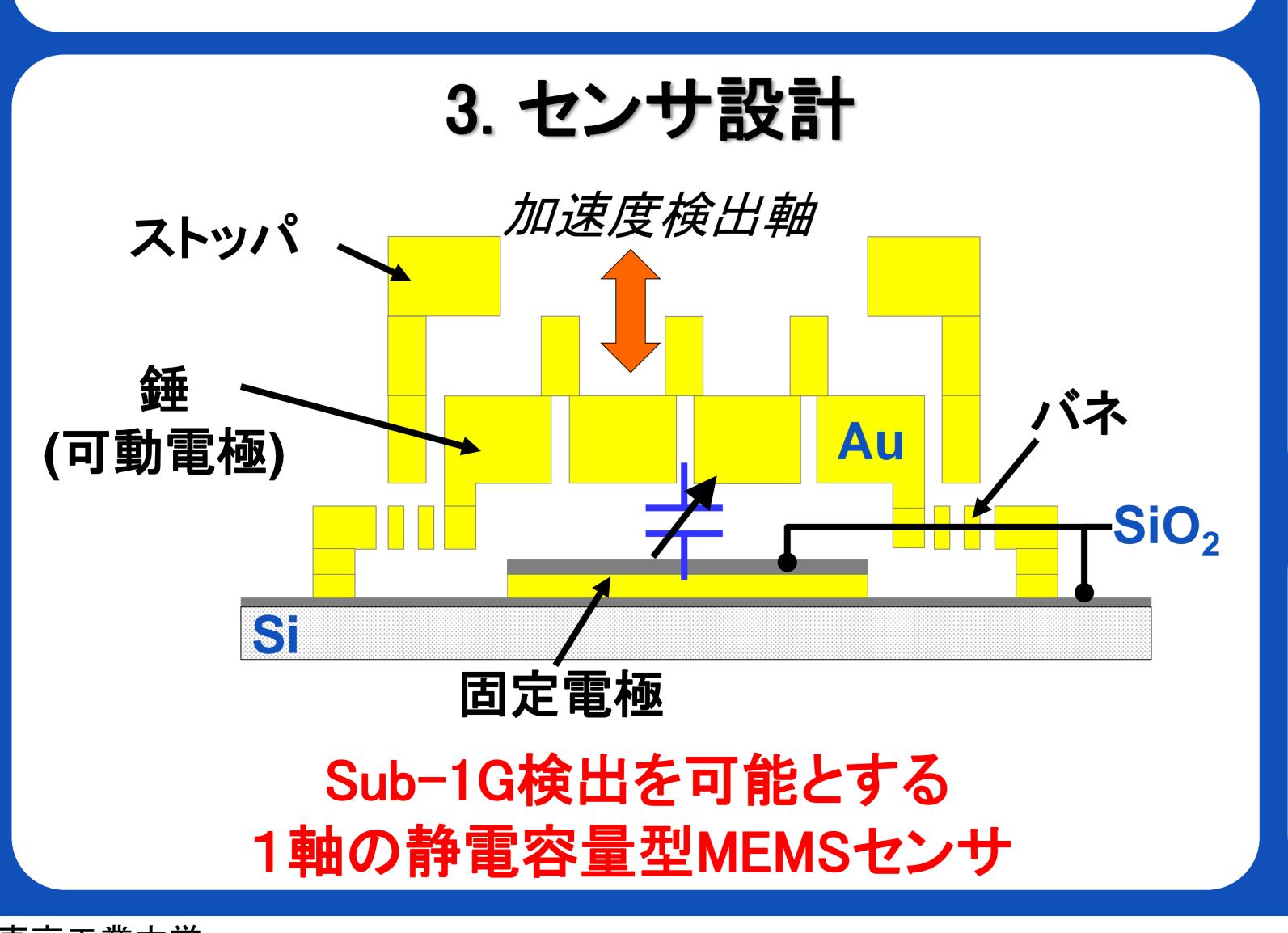
 $B_N = rac{\sqrt{|S|^B}}{9.8m}$  $k_B$ : ボルツマン定数 [J/K], T: 絶対温度 [K]

集積化CMOS-MEMS加速度センサ 目標検出範囲: Sub-1G ~ 20G

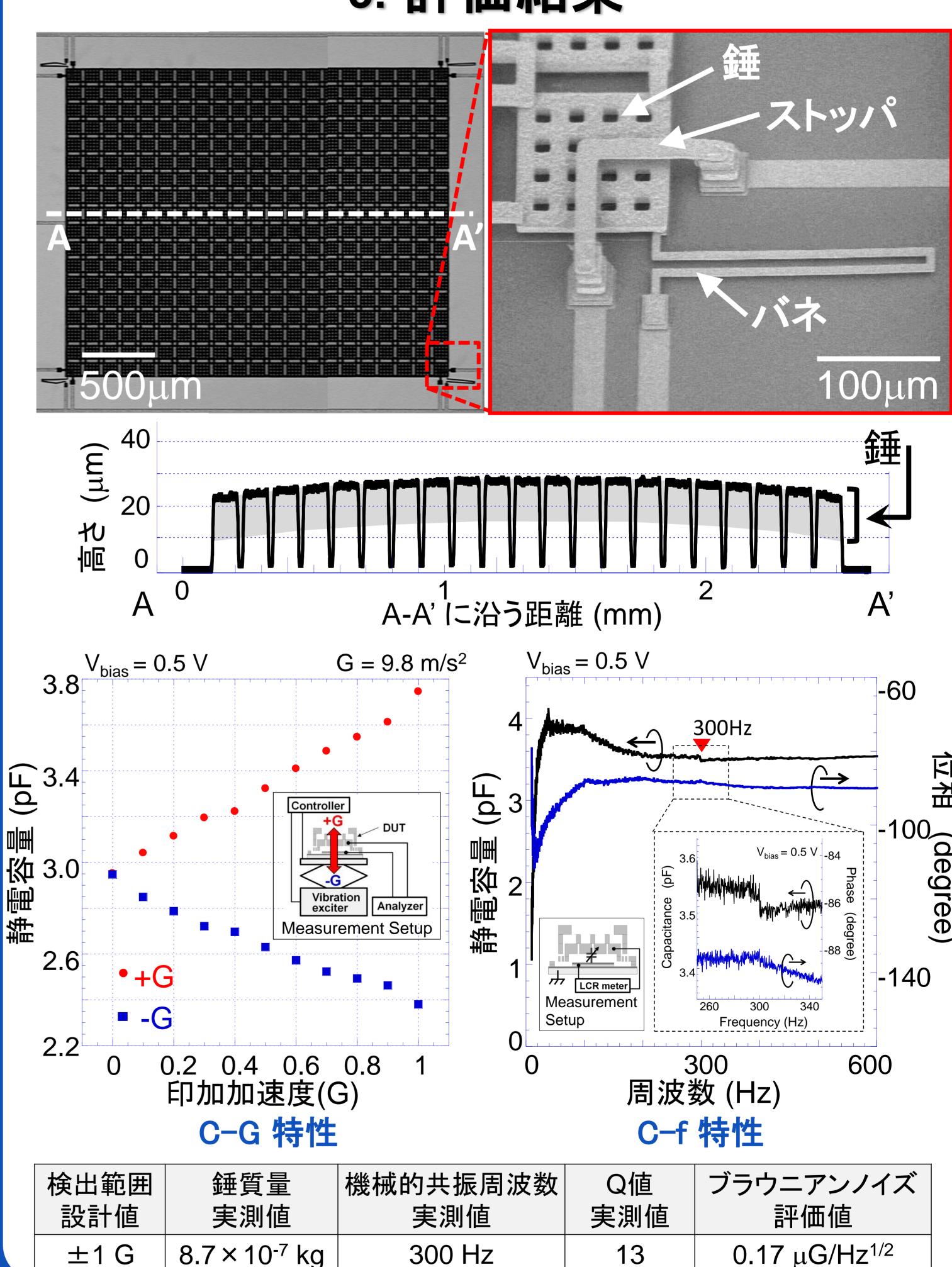


同省及の羅州和  $\Rightarrow$  錘小型化 &  $B_N$ 低減

- Sub-1Gセンサ設計論
- D. Yamane, et al., *Appl. Phys. Lett.* 104, 2014
- アレイ型加速度センサ
- T. Konishi, et al., *Jpn. J. Appl. Phys.* 53, 2014
- 集積化CMOS-MEMS加速度センサに向けた Sub-1Gセンサの検討 (本研究)



#### 5. 評価結果



### 6. 結論

#### 静電容量型 Sub-1G MEMS センサ

- 高密度(Au使用)の錘: 2.4 mm × 2.1 mm
- 評価結果: 錘の反り < 6  $\mu$ m,  $B_N = 0.17 \mu$ G/Hz<sup>1/2 4</sup>
- C-G特性評価によるSub-1G検出性能の確認

Sub-1G~20Gを検出可能な 集積化CMOS-MEMS加速度センサの実現見通しを得た

ΝΤΤΛΤ

従来のシリコンMEMS

 $> \sim 100 \mu G/Hz^{1/2}$ 

加速度センサ性能